
	<p><b>SI7850DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Référence fabricant:</b> <a href="#">SI7850DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Fabricant / Marque:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Une partie de la description:</b> MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Livret des spécifications:</b>  <a href="#">SI7850DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p><b>État du stock:</b> New original, 35878 pcs Stock Available.</p> <p><b>Bateau de:</b> Hong Kong</p> <p><b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Caractéristiques

Modèle de produit	<a href="#">SI7850DP-T1-GE3</a>
Fabricant	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
La description	MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8
Catégorie	<a href="#">Produits semi-conducteurs discrets &gt; Transistors - FET,</a>
État de la pièce	35878 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	PowerPAK® SO-8
Séries	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 10.3A, 10V
Dissipation de puissance (max)	1.8W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	PowerPAK® SO-8
Autres noms	SI7850DP-T1-GE3TR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	33 Weeks
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	60V
Description détaillée	N-Channel 60V 6.2A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	6.2A (Ta)

### Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p><b>SI7850DP-T1-E3 IC</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI7852ADP</b> SI SI7852ADP SI</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3 MOS</b> VISHAT VISHAT QFN-8</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-LF</b> VISHAY</p>
 <p><b>SI7850DP-T1-GE3 MOS</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3.</b> VIS VIS QFN8</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852ADP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>

### SI7850DP-T1-GE3 Mots-clés

Plus

SI7850DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SI7850DP-T1-GE3	Fiches techniques SI7850DP-T1-GE3	SI7850DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7850DP-T1-GE3
SI7850DP-T1-GE3 électronique	Composants SI7850DP-T1-GE3	Distributeur SI7850DP-T1-GE3	SI7850DP-T1-GE3 Image	Partie SI7850DP-T1-GE3
Prix SI7850DP-T1-GE3	SI7850DP-T1-GE3 Fabricant	SI7850DP-T1-GE3 Photo	Action SI7850DP-T1-GE3	SI7850DP-T1-GE3 Inventaire
SI7850DP-T1-GE3 Nouveau	SI7850DP-T1-GE3 Original	SI7850DP-T1-GE3 garanti	SI7850DP-T1-GE3 RFQ	SI7850DP-T1-GE3 Commande en ligne

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited